文字数 アウトライン

# \paragraph{背景}

\ref{ZrCr2Laves相のphonon計算による高温安定性}節では,ZrCr\$\_{2}\$ Laves相の各格子モデルに対する自由エネルギーを算出し,有限温度に おける相安定性を示した。

しかし、実験結果と計算結果で、一部整合しない点が見受けられた。

この一因として熱膨張を考慮していないことが考えられる.

相安定性の議論の際、自由エネルギー算出に用いたMedeA-Phononは、熱振動効果を加味するものの、熱膨張は取り入れることができない。 本節では3C、4H-SiCを計算対象とし、このMedeA-Phononを使って、作為的な格子定数変化から、ある温度域での最安定構造を求めることで、 算出した熱膨張率を紹介する。

# ▼ \paragraph{手法}

3C-SiCは\$c/a\$比が1となり,立方晶を形成する.

\subsection{SiC結晶多形における熱膨張率}

それに対し、4H-SiCは、VASPで構造最適化を行うと、\$c/a\$比が3.10となる.

したがって熱膨張を議論する際、3C-SiCは\$a\$軸、\$c\$軸方向に等倍率な線形膨張を考えればよいが、4H-SiCは\$a\$軸と\$c\$軸の線形膨張率が異 なる.

今回利用したMedeA-Phononは一定体積のもと、系の自由エネルギーの温度依存性を計算する.

そこで3C-SiCは\$a\$軸, \$c\$軸方向に等倍率で格子定数を変化させ, 各モデルの自由エネルギーを求め, 各温度での最適な構造を検証し, 熱膨張 を求めた.

4H-SiCは\$a\$軸、\$c\$軸方向を別々に格子定数を変化させ、各温度における自由エネルギーの格子定数依存性を表すエネルギーサーフェイスを描り た.

そしてその極小値をとる格子定数を算出し、各温度における最適なモデルを求めることから、\$a\$軸、\$c\$軸各々に対する線形膨張率の温度依存性 を求めた。

%そこで作為的に格子定数を変化させ、各モデルの自由エネルギーを算出することから、各温度での最適な構造を検証し、熱膨張率を求めた。

#### \if0

\begin{figure}[htbp]

## ▼ \paragraph{結果}

図\ref{3C Thermal Energy Surface}は各温度における3C-SiCの自由エネルギーの格子定数依存性を示している.

横軸とした\$a/a\$\$\_{0}\$における,\$a\$\$\_{0}\$は零点振動を加味していない基底状態における格子定数,\$a\$はある温度における最適な構造の格子 定数を示している.

各温度の自由エネルギー曲線における極小値は、平衡格子定数における自由エネルギーを示している。

これによると温度の上昇とともに、平衡格子定数も増加し、熱膨張を再現している。

### \begin{figure}[htbp]

一方、図\ref{4H Thermal Energy Surface}は各温度における4H-SiCの自由エネルギーの\$a\$軸、\$c\$軸の依存性を示している。

すべての温度域において,基底状態における平衡格子定数((\$a/a\$\$\_{0}\$, \$c/c\$\$\_{0}\$)=(1.0,1.0))を青点,(a)500K (b)1000K (c)1500Kに ける平衡格子定数を赤点で示している。

こちらも3C-SiCと同様に、温度上昇とともに平衡格子定数が推移し、熱膨張を再現していることがわかる。

### \begin{figure}[htbp]

図\ref{SiC Thermal Expansion}は、図\ref{3C Thermal Energy Surface}と図\ref{4H Thermal Energy Surface}で示した各温度域の平衡格 子定数を用いて求めた(a)3C(b)4H-SiCにおける線形膨張率と、実験的に報告されている線形膨張率を示している。

両図とも実験値と計算値の最大の差分は0.03\%ほどであり、計算値と実験値が非常に良く整合している。

また4H-SiCの熱膨張に関して,\$a\$軸が\$c\$軸よりも膨張しやすいという知見を得た.

\begin{figure}[htbp]

#### 21

314

28

14

14 493

26

14 242

21 245

21

262